

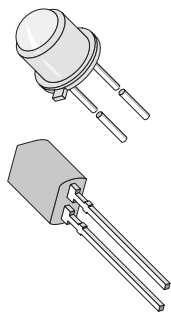
ФОТОДИОДЫ И ФОТОТРАНЗИСТОРЫ



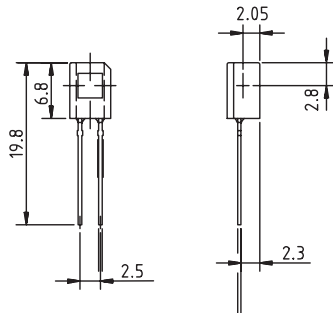
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Тип	Угол 2 Θ 1/2°	Длина волны, нм	Диапазон волн, нм	Максимальный темновой ток коллектора, нА	Материал	Макс. раб. частота, кГц	Диапазон рабочих температур, °С	Площадь чувствительного элемента, мм ²
BPW17N	фототранзистор	24	825	620 - 960	200	кремний	120	-55...+100	0.36
BPW20RF	фотодиод	100	920	550 - 1040	34	кремний	70	-55...+125	7.5
BPW21R	фотодиод	100	565	420 - 675	30	кремний	80	-55...+125	7.5
BPW24R	PIN фотодиод	24	900	600 - 1050	10	кремний	35700	-55...+125	0.78
BPW34	PIN фотодиод	130	900	600 - 1050	30	кремний	2500	-55...+100	7.5
BPW41N	PIN фотодиод	130	950	870 - 1050	30	кремний	2500	-55...+100	7.5
BPW85B	фототранзистор	50	850	620 - 980	200	кремний	180	-55...+100	0.18
BPW85C	фототранзистор	50	850	620 - 980	200	кремний	180	-55...+100	0.18
BPW96C	фототранзистор	40	850	620 - 980	200	кремний	180	-55...+100	0.18

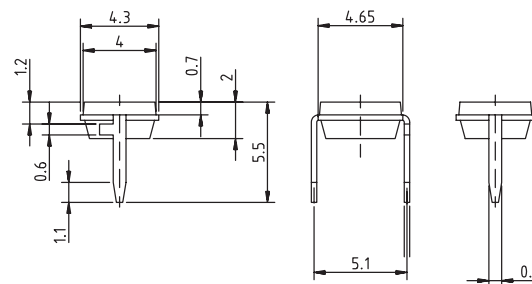
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



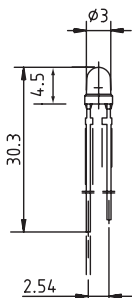
BPW41N



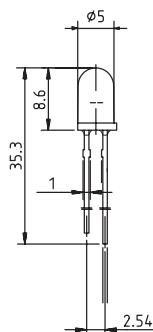
BPW34



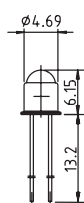
BPW85



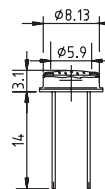
BPW96C



BPW24R



BPW20RF, BPW21R



BPW17N

